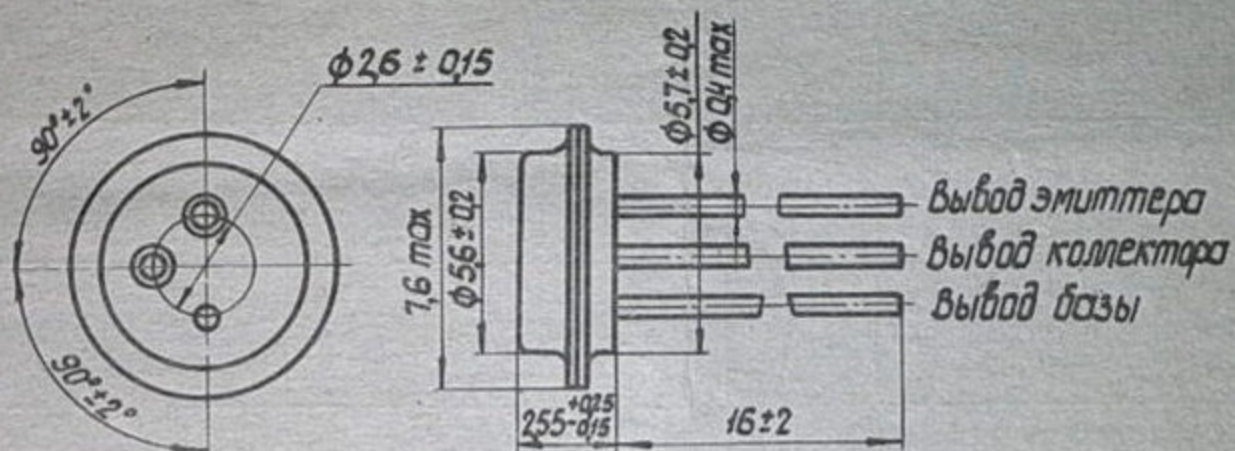




ПАСПОРТ

НА ТРАНЗИСТОРЫ ГЕРМАНИЕВЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ Р-П-Р ТИПОВ:
ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д

Соответствует техническим условиям 3.365.015 ТУ



1. Электрические параметры при $t_{amb} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$

№ п. п.	Наименование параметров и режимы измерения	Услови. обозн.	Ед. изм.	Норма	Типы транзисторов				
					ГТ115А	ГТ115Б	ГТ115В	ГТ115Г	ГТ115Д
1	Обратный ток коллектора при $U_{CB} = -20$ В	I_{CBO}	мкА	max	40		40		40
	Обратный ток коллектора при $U_{CB} = -30$ В	I_{CBO}	мкА	max		40		40	
2	Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = -20$ В	I_{EBO}	мкА	max	40	40	40	40	40
3	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{CB} = -1$ В, $I_E = 25$ мА	h_{21e}		min	20	20	60	60	125
				max	80	80	150	150	250
4	Предельная частота передачи тока при $U_{CB} = -5$ В, $I_E = 5$ мА	f_{h21v}	МГц	min	1	1	1	1	1

2. Предельно допустимые эксплуатационные данные

№ п. п.	Наименование параметров	Един. изм.	Типы транзисторов				
			ГТ115А	ГТ115Б	ГТ115В	ГТ115Г	ГТ115Д
1	Максимально допустимое напряжение коллектор—база при $t_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$ $U_{CB \max}$	В	-20	-30	-20	-30	-20
2	Максимально допустимое напряжение эмиттер—база при $t_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$, $U_{EB \max}$	В	-20	-20	-20	-20	-20
3	Мощность, рассеиваемая на транзисторе, P_{\max}	мВт	50	50	50	50	50
4	Температура окружающей среды t_{amb}	$^{\circ}\text{C}$	от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$				

3. Указания по эксплуатации

1. В процессе работы не разрешается превосходить предельно допустимые значения токов, напряжений, мощности и температуры.

2. Не рекомендуется использование транзисторов в предельных режимах одновременно по двум или более параметрам.

3. Необходимо принимать меры по обеспечению минимальной температуры корпуса транзистора.

4. Пайка выводов транзистора разрешается на расстоянии 3 мм от корпуса транзистора.

5. Пайку следует производить паяльником мощностью 30 Вт в течение времени не более 5 с, температура пайки не должна превышать $+200 \pm 20^{\circ}\text{C}$. При пайке должен быть обеспечен теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.

6. Применение при пайке кислотосодержащих флюсов не допускается.

Штамп ОТК.

Зак. 2599.

Проверено 19.9.80, Фисс